

전자소자 (김학린)

HW#11 (04/20, 월요일) - (제출마감일 : 4/26 일요일)

1. HEMT 소자에서 bandgap engineering을 통한 channel의 modulation doping 효과에 대해 원리를 설명하고, 일반 JFET 및 MOSFET 대비 가지는 장점에 대해 물리적 이유와 함께 설명해 보시오.